## 半導體元件物理與製

Semiconductor Device Physics and Process

M 310: 101 0M 610110 101 01011101 610 001 011011

以深入淺出的方式,系統性地介紹目前主流半導體元件(CMOS)之元件物理與製程整合所必須具備的基礎理論、重要觀念與方法、以及先進製造技術。内容可分為三個主軸:第一至第四章涵蓋目前主流半導體元件必備之元件物理觀念、第五至第八章探討現代與先進的 CMOS IC之製造流程與技術、第九至第十二章則討論以CMOS元件為主的IC設計和相關半導體製程與應用。由於強調觀念與實用並重,因此儘量避免深奧的物理與繁瑣的數學;但對於重要的觀念或關鍵技術均會清楚地交代,並盡可能以直觀的解釋來幫助讀者理解與想像,以期收事半功倍之效。

本書宗旨主要是提供讀者在積體電路製造工程上的 know-how 與 know-why:並在此基礎上,進一步地介紹最新半導體元件的物理原理與其製程技術。它除了可作為電機電子工程、系統工程、應用物理與材料工程領域的大學部高年級學生或研究生的教材,也可以作為半導體業界工程師的重要參考。

本書內容足以提供連續兩學期的半導體元件物理與製程技術的課程。若是一個一學期的 課程,則教師可以使用第一章至第五章的內容來講授半導體元件物理;或是使用第一章與第 五章至第八章的內容來講授現代半導體製程技術。



